

Références Bibliographiques

- [1] F. Djefal. Modélisation et simulation du transistor MOSFET fort submicronique. Application à la conception des dispositifs intégrés. Thèse de doctorat 2006. Université de Batna.
- [2] Thomas SKOTNICKI. Transistor MOS et sa technologie de fabrication. Docteur en microélectronique, Ingénieur de recherche à France Télécom, Centre national d'études des télécommunications (CNET) de Grenoble, Ingénieur ST Microélectroniques.
- [3] -<http://www.electronique-radiomateur.fr/elec/composant/mos.php>.
- [4] -http://fr.wikipedia.org/wiki/Transistor_à_effet_de_champ_à_grille_métal-oxyde
- [5] D.Ginhac. De la physique des semi conducteurs aux transistors MOS- Thèse de doctoral-2007-Université de bourgogne-Aile Sciences de l'Ingénieur.
- [6] Henry Mathieu. Physique des semi-conducteurs et des composants électroniques 3^{ème} édition.DUNOD.
- [7] M. Bucher, “Analytical Modelling of the MOS Transistor for Circuit Simulation”, Ph. D.Thesis N° 2114 (1999), Swiss Federal Institute of Technology (EPFL), Lausanne, Switzerland.
- [8] The EPFL-EKV MOSFET Model Equations for Simulation Matthias Bucher, Christophe Lallement, Christian Enz, Fabien Théodoloz, François Krummenacher Electronics Laboratories, Swiss Federal Institute of Technology (EPFL), Lausanne, Switzerland. Model Version 2.6, June, 1997

- [9] J.-M. Sallese, M. Bucher, C. Lallement, "Improved Analytical Modelling of Polysilicon Depletion in MOSFETs for Circuit Simulation", Solid State electronics, Vol. 44, N° 6, pp. 905-912, June 2000.
- [10] M. Bucher, A.-S. Porret, J. M. Sallese, F. Krummenacher, "The Foundations of The EKV MOS Transistor Charge-Based Model",
- [11] Compact Model Challenges of 65nm RF RF-CMOS technology
TOSHIBA Corp. Semiconductor Company. Copyright 2008 TOSHIBA
Corporation MOS-AK Meeting 2008 Edinburgh
- [12] Antonios Bazigos ,Matthias Bucher, EKV3.0 model code & parameter extraction, EKV Users' Meeting/Workshop November 4-5, 2004, EPFL,
Lausanne, Switzerland
- [13] Yvan Bonnassieux, "Introduction à l'électronique analogique" PHY568
Microelectronique Promotion 2003
- [14] K.eshbaugh, "Generation of correlated parameters for statistical circuit simulation", IEEE Trans.on CAD, vol.11,no.10,Oct.1992.
- [15] RF.Jurgens, "High Temperature Electronics Applications in Space Exploration",
IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol.IE-29, NO.2, May1982, pp
107-111.